

平成 31 年 2 月 28 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会 「結晶加工と評価技術」 第 145 委員会
第 163 回研究会開催通知

第 145 委員会, 第 161 委員会 合同研究会

テーマ: 「窒化物半導体における欠陥低減技術の進展と評価技術の最前線」

日時: 2019 年 5 月 8 日 (水) 13:00~17:40

会場: 明治大学紫紺館 4 階会議室(S5・S6・S7)

https://www.meiji.ac.jp/koyuka/shikonkan/copy_of_shikon.html

東京都千代田区神田小川町 3-22-14 (TEL 03-3296-4727)

JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

世話人: 酒井 朗 (大阪大学), 三宅 秀人 (三重大学), 上田 修 (金沢工業大学)

(以上, 第 145 委員会)

寒川 義裕 (九州大学), 三宅 秀人 (三重大学) (以上, 第 161 委員会)

プログラム

- 13:00~13:05 開会挨拶 (第 145 委員会) 柿本 浩一 (九州大)
- 13:05~13:10 開会挨拶 (第 161 委員会) 藤岡 洋 (東京大)
- 13:10~13:15 はじめに 酒井 朗 (大阪大)
- 13:15~13:55 「HVPE 法による高品質 GaN バルク・エピ成長技術」
藤倉 序章、井上 敏寿、北村 寿朗、今野 泰一郎、鈴木 貴征、藤本 哲爾、
吉田 丈洋、堀切 文正 ((株)サイオクス)、三島 友義 (法政大学)
- 13:55~14:35 「スパッタ・アニール法による AlN 転位密度の低減技術」
上杉謙次郎、三宅秀人 (三重大)
- 14:35~15:15 「GaN, AlN のエッチピット、X 線トポと TEM による転位観察」
石川由加里 (JFCC)
- 15:15~15:35 休憩
- 15:35~16:15 「ラマン分光法による GaN 単結晶における貫通転位の歪み場解析」
小久保信彦 (名古屋大、産総研、現(株)日立製作所)、角岡洋介 (名大、産総研)、
藤榮文博 (名大)、大原淳士 (DENSO)、恩田正一 (名大)、山田永 (産総研)、
清水三聡 (産総研)、原田俊太 (名大)、田川美穂 (名大)、宇治原徹 (名大、
産総研)
- 16:15~16:55 「多光子顕微鏡による GaN 結晶中の転位伝搬評価」
谷川 智之、松岡隆志 (東北大)
- 16:55~17:35 「放射光ナノビーム X 線回折による窒化物半導体結晶中の欠陥評価」
酒井 朗 (大阪大)、今井康彦 (JASRI)
- 17:35~17:40 おわりに 上田 修 (金沢工大)
- 18:00~20:00 意見交換会 (明治大学、リバティータワー23 階宮城浩蔵ホール)
http://www.meiji.ac.jp/ksys/classroom/room.html?id=LT_23F_2&rm=L123B